

シリコンPNPエピタキシャルプレーナ型トランジスタ (2SC3264とコンプリメンタリ)

用途：オーディオ、一般用

絶対最大定格 (Ta=25)

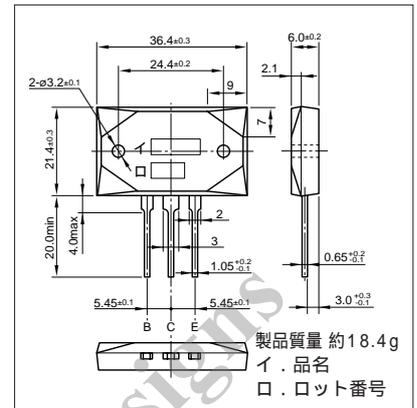
記号	規格値	単位
V _{CB0}	-230	V
V _{CE0}	-230	V
V _{EB0}	-5	V
I _c	-17	A
I _B	-5	A
P _c	200(T _c =25)	W
T _{ij}	150	
T _{stg}	-55 ~ +150	

電気的特性 (Ta=25)

記号	試験条件	規格値	単位
I _{CB0}	V _{CB} = -230V	-100max	μA
I _{EB0}	V _{EB} = -5V	-100max	μA
V(BR) _{CEO}	I _c = -25mA	-230min	V
h _{FE}	V _{CE} = -4V, I _c = -5A	50min	
V _{CE(sat)}	I _c = -5A, I _B = -0.5A	-2.0max	V
f _r	V _{CE} = -12V, I _E = 2A	35typ	MHz
C _{OB}	V _{CB} = -10V, f = 1MHz	500typ	pF

ランク O(50~100), Y(70~140)

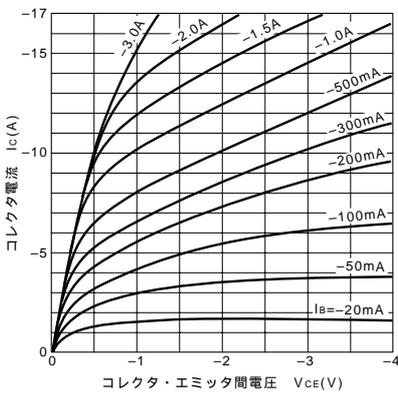
外形図 MT-200



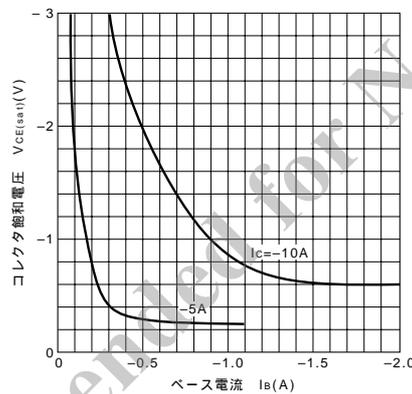
代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _c (A)	V _{BB1} (V)	V _{BB2} (V)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _{on} (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
-60	12	-5	-10	5	-500	500	0.35typ	1.50typ	0.30typ

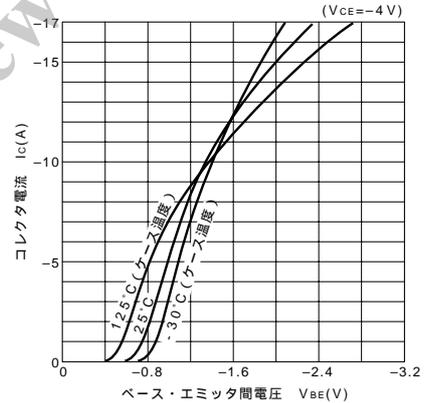
I_c-V_{CE}特性 (代表例)



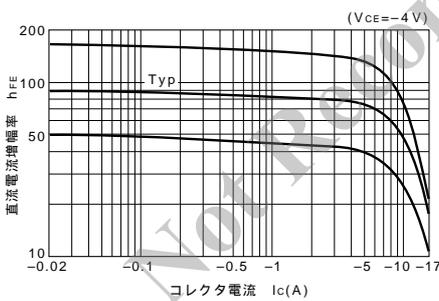
V_{CE(sat)}-I_B特性 (代表例)



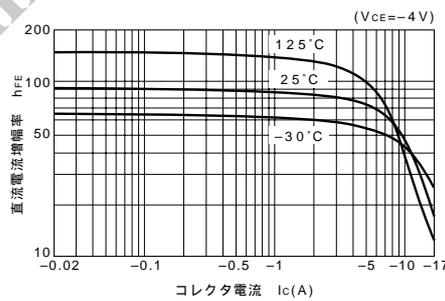
I_c-V_{BE}温度特性 (代表例)



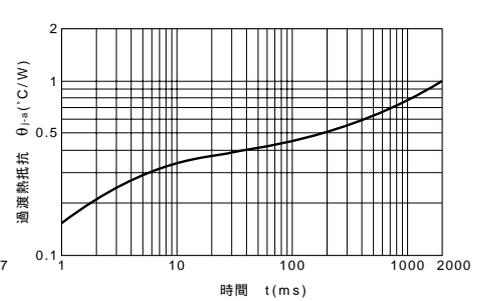
h_{FE}-I_c特性 (代表例)



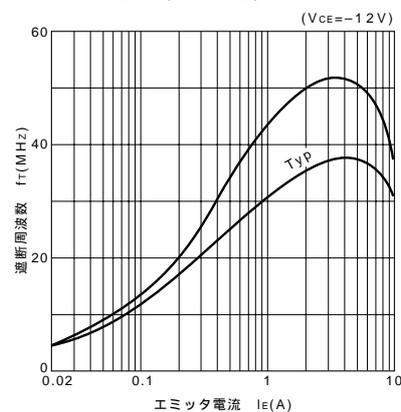
h_{FE}-I_c温度特性 (代表例)



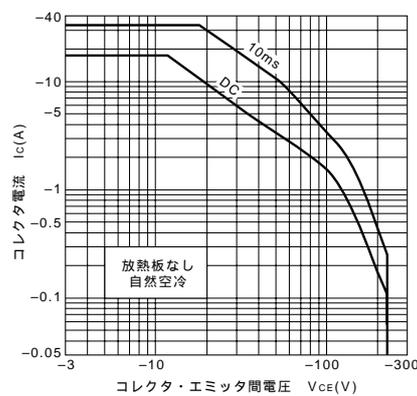
θ_{ja}-t特性



f_T-I_E特性 (代表例)



ASO曲線 (単発パルス)



P_c-T_a定格

